#### 解説

## SR-X線トポグラフィで見る氷結晶中の 点欠陥の挙動

## 本堂武夫

#### 北海道大学工学部応用物理学科

### Nature and behavior of point defects in ice revealed by synchrotron radiation topography

#### **Takeo Hondoh**

Department of Applied physics, Hokkaido University.

Recent synchrotron-radiation topographic studies on point defects in ice crystals are briefly reviewed. It is shown that all of the point-defect parameters can be determined by the X-ray topographic observations of dislocation climb caused by emission or absorption of the point defects. Since, in these studies, a new method has been developed for determining point defect diffusivity separately from the defect concentrations as functions of both temperature and pressure, a principle and an experimental technique of this method are described in detail. Those parameters obtained for ice are compared with self-diffusion data, and are discussed in a relation to melting behavior of ice.

#### 1. はじめに

多くの物質において,融点と自己拡散係数の相 関が指摘されており,氷においても圧力の増加と 共に自己拡散係数が大きくなることが報告されて いる<sup>11</sup>。これは、自己拡散の活性化体積 V.が負で あることを示しており、格子間機構の結果として 解釈されている。良く知られているように、氷は すき間の多い結晶の典型的な例であり、融解に伴 う体積変化が負である。このような結晶中では、 自己格子間原子(分子)が、空孔よりも優勢な点 欠陥として拡散を支配する可能性があり、実際氷 ではこのことが実証されている<sup>21 3) 4) 5)</sup>。しかし、 このことからただちに V. < 0 と結論することはで

#### きない。

自己拡散係数D,は、その担い手である点欠陥の 平衡濃度(モル分率)c。と拡散係数Dの積に等し い。拡散の担い手が複数の種類の点欠陥であれ ば、添字jで点欠陥の種類V(空孔)あるいは I(自己格子間原子)等を表わすことにすれば、

$$D_{s} = \sum_{i} c_{e}^{i} D^{i}$$
<sup>(1)</sup>

と書ける。仮に $c_*^{\circ} \gg c_*^{\circ}$ としても、D.の圧力依存性 には、 $c_*^{\circ} \ge D^{\circ}$ 両方の圧力依存性が反映するから、 格子間機構だからといって、V. < Oとは限らな い。 $c_*^{\circ}$ が圧力の増加と共に大きくなる(全系の体 積を減少させる)のは間違いないとしても、D'は 逆に小さくなるからである。ところが、従来の議 論はこれらを明確に区別せずに行われてきたきら いがある。というよりも、D'を独立に測る方法が なかったし、c<sup>1</sup>の測定も極めて難しい。氷結晶中 のc<sup>1</sup>は融点でも3×10<sup>-6</sup>(モル分率)に過ぎない ことが今では知られているが<sup>33</sup>、平衡濃度の低さが その測定を困難にしてきた。

ここで紹介するX線トポグラフィ(XRT)を用 いる方法は、D'とc<sup>1</sup>を独立に測定することができ るし、その積D,を測ることもできる。何故可能か という点については次節以後で説明するが、一言 で言うならば、点欠陥の熱平衡状態からのずれに 対して鋭敏に応答する転位の挙動を利用するので ある。まだ、一連の実験は完了していないので、 冒頭に挙げた問題に完全には答えられないが、こ の方法の有効性は十分に納得して頂けるものと思 う。この方法自体は汎用性を持っているが、完全 性の良い結晶が得られて、融点近傍の実験が容易 であるという理由で、今のところ氷にしか適用さ れていない。もちろん、上記のような氷特有の興 味ある問題も、対象を氷に絞らせている理由の1 つである。

#### 2. 刃状転位の上昇運動と点欠陥

#### 2.1 氷結晶中の点欠陥

図1に通常の氷(I<sub>h</sub>)の単位胞を示した。白丸 が酸素原子の位置であり、ウルツ鉱型結晶(六方 晶)の2種の原子を酸素原子Oで置き換えた構造 と見ても良い。O-O間は、太線で示した水素結 合で結ばれており、各結合上に1個の水素原子H が存在する。Oのまわりには2個のHがあってH<sub>2</sub> Oを形成しているが、Hの配置(水分子の配向)に は任意性があり、1種のdisorder状態にある。こ のdisorder状態には、上記の水素結合の条件と水 分子の条件が課せられており、これらを合わせ て、Bernal-Fowler則あるいはice rule(氷の 条件)と呼んでいる。



Fig.1. A unit cell of ice  $I_{h}$ , a=4.52A, c=7.36A. Details of the interstices Tu and Tc are given in Fig.2.

水結晶の点欠陥としては、このice ruleを破る 点欠陥すなわちプロトン配置の点欠陥と水分子と しての点欠陥すなわち空孔と自己格子間分子が存 在する。さらに、これらの複合された点欠陥も考 えられる。しかし、この解説で問題にする拡散現 象では、水分子としての点欠陥が主役であり、こ こでは、空孔と自己格子間分子のみを考える。

空孔(vacancy)は、格子点にあるべき水分子 が欠けている状態であり、氷結晶中の空孔は、 Eldrupら<sup>69</sup>の陽電子消滅の実験によって、その存 在が確認されている。しかし、空孔の形成エネル ギーも移動エネルギーも確かなことは分かってい ない。一方、自己格子間分子に関しては、冷却に よって発生する転位ループが格子間型であること から、それが優勢な点欠陥であることが確認され ている<sup>2159</sup>。そればかりか、次節で述べる方法によ って、自己格子間分子のパラメータが表1のよう に決定されている。

氷結晶の格子間位置としては、ウルツ鉱型結晶



Fig.2. Interstitial sites in ice I<sub>h</sub> structure. The capped trigonal – site Tc and the uncapped trigonal – site Tu<sup>20</sup>.

と同様2種類のtrigonal (T) siteがある。図1お よび図2に,記号T<sub>c</sub> (capped)とT<sub>u</sub> (uncapped) で示した。T<sub>c</sub> siteの最近接格子点は,この三角プ リズムのキャップになっているEであり,T<sub>c</sub>とE の距離は2.31Aである。T<sub>u</sub> siteの方は,非常に 広い空間を持っており,最近接格子点A,B,D との距離は,2.95Aであり,O-O水素結合距離 2.76Aよりも長く,水分子のvan der Waals 半径1.4Aの2倍よりも大きい。すなわち,分子の 大きさだけを考えるならば,T<sub>u</sub> siteは水分子を収 容するに十分である。

#### 2.2 転位ループの構造

点欠陥は,熱平衡状態として結晶中に存在する が,温度変化等の擾乱によって,平衡濃度からの ずれを生ずると,平衡を達成するために点欠陥の 生成・消滅が生ずる。最も有効なsink,sourceは 自由表面であるが,結晶内部の刃状転位も有効に 働く。特に,過飽和度(あるいは未飽和度)が十 分大きくなると,転位ループが生成され,点欠陥 のsink(あるいはsource)として活動する。図3 は,そのようなループの断面の原子配置を示して いる。図3(b)は,底面(0001)に沿って, 1原子層余分な原子面が入った状態であり,過剰 になった自己格子間分子の析出によって生ずる。 この析出によって,元の格子はc/2の相対変位を 受けるが,この変位が結晶の並進ベクトルに一致







しないので、析出面に積層欠陥を生ずる。

図3(b)の黒丸原子は、元の状態(六方晶)と は違うダイヤモンド構造(立方晶)の環境に置か れており、この場合、ダイヤモンド構造が3原子 層にわたっている。図3(a)は、(b)の状態か らさらに、 $\mathbf{p} = (1/3) < 10\overline{10} > だけ相対変位$ を行った状態に対応しており、ダイヤモンド構造 は1層に減少している。いずれの場合も、図の右 側に示した積層構造に不整が生じており、積層欠 陥の名がついている。

(a) と(b) どちらが安定かは、転位ループの大

きさによる。上記の説明で、(b)の積層欠陥は(a) に較べて約3倍の積層欠陥エネルギー(単位面積 当たり)を持つことが分る。一方、転位の自己エ ネルギー(単位長さ当り)は、そのバーガース・ ベクトルbの大きさの2乗に比例するから、(a) は(b)の場合の約1.5倍になる。したがって、転 位ループが小さい時は、(b)の方が安定であり、 大きくなると(a)が安定になる。XRTで観察さ れるのは、直径数百 $\mu$ mから数mmの大きなルー プであり、(a)の構造が観察される。

(a), (b) どちらの構造でも,四面体配置が保存されるのは,この積層欠陥が底面上に存在する時のみである。したがって,さらに自己格子間分子を吸収して,ループが拡大する時も,転位は底面上を移動する。(b)のタイプでは,この運動は bに垂直な方向に生ずるので純粋な上昇運動となるが,(a)のタイプではすべり運動を伴う。しかし,このすべり運動に要する力は,上昇運動に要する力に比べてはるかに小さいので,特に障害とはならない。

図(a)の上にさらにもう1層析出すると、(c /2+p<sub>i</sub>) + (c/2+p<sub>2</sub>) = c + a となって、積層 欠陥は消滅して、完全転位ループとなる。この 時、 $p_2$ ではなくて、 $-p_i$ だけずれるかあるいは ループ形成の初期の段階で図(b)の析出が続いて 生ずると、b = cの完全転位ループとなる。

#### 2.3 上昇運動の駆動力

前節で述べたように, 点欠陥の吸収あるいは放 出によって, 刃状転位は上昇運動をする。上昇運 動を引き起こす駆動力となるのは, (1)点欠陥濃 度の熱平衡状態からのずれ, (2)転位の湾曲によ る線張力, (3)積層欠陥の張力, (4)外応力等 である。この中で, (1)が最も大きな駆動力にな り得る。言い換えると, 上昇運動は点欠陥の過不 足状態に敏感に応答する。

半径 r, バーガース・ベクトル b の転位ループに 対して, 上記(1)~(4)の駆動力(転位単位長 さに働く力)はそれぞれ以下の式で表わされる<sup>7</sup>。 ただし、上昇運動はループ面に平行な方向にのみ 生ずると仮定している(前節参照)。また、1種 類の点欠陥が優勢であるとして、添字V、I等は 省略する。

$$F_{os} = \frac{kT b_{n}}{v_{a}} \ell n \left(\frac{c_{\ell}}{c_{e}}\right)$$

$$F_{\ell} = \frac{1}{r} \frac{\mu}{4\pi(1-\nu)} \left[\frac{2-\nu}{2} b_{p}^{2} \left(\ell n \left(\frac{4r}{\rho}\right) - 1\right)\right]$$
(2)

$$+ b_n^2 \ell n \left(\frac{4r}{\rho}\right)$$
 (3)

$$F_{sf} = \gamma_{sf} \tag{4}$$

$$\mathbf{F}_{\sigma} = \sigma \mathbf{b}_{\mathsf{n}} \tag{5}$$

ここで、 $v_a$ は原子容、 $c_a$ は転位のまわりの点欠陥 濃度、 $c_a$ 平衡濃度、 $\mu$ 剛性率、 $\nu$ ポアソン比、 $b_n$ と $b_a$ は、bのループ面に垂直な成分と水平成分、  $\rho$ コア・カットオフ・パラメータ、 $\gamma_{st}$ 積層欠陥エ ネルギー、 $\sigma$ はループ面に働く垂直応力である。

 $c_{\ell} = c_{e}$ の時( $\sigma = 0$ とする),  $F_{\ell}$ と $F_{st}$ を駆動力 として転位ループは縮小する。このような場合に ついては、次節で論ずる。 $c_{\ell}$ が平衡濃度 $c_{e}$ と違っ ていて、 $F_{os}$ がちょうど $F_{\ell} + F_{st}$ と釣り合っている 時、すなわち転位が静止している時の $c_{\ell}$ を $c'_{e}$ とす ると、 $c'_{e}$ は転位のまわりの局所平衡濃度であり、

$$F_{e} + F_{st} = \frac{kTb_{n}}{v_{a}} \ell n \left(\frac{c'_{e}}{c_{e}}\right)$$
(6)

を満足している。(2)式と(6)式の差が転位を 動かす力であるから、これをFと書くと、

$$F = \frac{kTb_n}{v_a} \ln \left( \frac{c_\ell}{c'_e} \right)$$
(7)

となる。点欠陥がわずか1%過剰(c<sub>4</sub>/c'<sub>a</sub>≈1.01) になっても、それによる駆動力は、(5)式でσ≈ 1MPaの応力による駆動力に匹敵する。

2.4 点欠陥過剰量のセンサーとしての刃状転位 刃状転位の上昇運動が点欠陥の熱平衡状態に対 する過不足に敏感であることを利用して,刃状転 位をその過剰量(不足量)のセンサーとして使う ことができる。センサーとしての働きは必ずしも 単純ではないが,適当な条件下では極めて有用な センサーとなり得る。また,これに代る適当な測 定方法がないのが現状である。

上昇運動の速度を律速する過程として、次の2 つのメカニズムが考えられている。(1)点欠陥の 転位からの放出(吸収)速度が律速する、(2)転 位のまわりから十分遠方までの点欠陥の拡散速度 が律速する。前者の場合,転位の上昇速度は、そ のまわりの点欠陥濃度  $c_i$ の局所平衡濃度  $c'_o$ からの ずれに比例し、 $c_i$ は十分遠方の濃度 c に等しい。 一方、後者では、 $c_i$ は常に  $c'_o$ に保たれ、拡散流束 は十分遠方の濃度 c と  $c'_o$ の差に比例する<sup>8)</sup>。両者 は両極端の場合であって、実際はこの中間の状態 が実現されるが、いずれにせよ上昇速度  $v_o$ は c - $<math>c'_o$ に比例すると考えてよい。 $\alpha$ を比例定数として、

$$\mathbf{v}_{c} = \alpha \left( \mathbf{c} - \mathbf{c}'_{e} \right) \tag{8}$$

αは、上昇運動のメカニズムに依存し簡単には 決められない量であるが、以下のような条件下で は、αを使わずに点欠陥の拡散係数Dを決めるこ とができる。少数の転位ループを含む平板結晶を 高温から温度Tまで冷却すると、過剰になった点 欠陥は最大のsinkである表面に向って拡散移動す る。転位ループも吸収するが、低転位密度の結晶 では、この量は無視できる。したがって、過剰点 欠陥の濃度分布は、図4のような分布すなわち、

$$\Delta \mathbf{c}(\mathbf{x}, \mathbf{t}) = \mathbf{c}_{o} \sin(\pi \mathbf{x}/\mathbf{d}) \exp(\pi^{2} \mathbf{D}_{\mathbf{x}} \mathbf{t}/\mathbf{d}^{2})$$
(9)

と与えられる。ここで、 x は試料表面に垂直にとった位置座標、 d 試料の厚さ、 D<sub>x</sub>は x 方向の点欠陥の拡散係数である。過飽和度が十分高ければ、  $c - c'_{e^{pprox}} c - c_{e}$ と置いて良いから、(8) 式と(9) 式から次の関係式を得る<sup>4</sup>。



Fig.4. Concentration profiles of the excess point defects and dislocation climb <sup>16)</sup>.

$$L_{t} - L(t) = L_{t} exp(-\pi^{2} D_{x} t/d^{2})$$
(10)

L(t) は上昇距離であり、最終的にはL<sub>i</sub>だけ移動す る。(9) 式には、 $\alpha$ もxも含まれていないから、 上昇機構の詳細および転位が表面からどういう距 離にあるかということにも無関係に、試料の厚さ dと上昇距離L(t)の測定のみから拡散係数D<sub>x</sub>を求 めることができる。ただし、転位は試料表面に平 行に移動するものとしている。また、 $c - c'_{e} \approx c$  $- c_{e}$ の近似が許されるほど熱平衡状態からのずれ が大きい状態を作る必要がある。

透過電子顕微鏡(TEM)観察では、電子線照射 によって強制的に過剰点欠陥が導入されるが<sup>9)</sup>, XRTの場合,試料の温度を変えるだけで十分であ る。これは、完全性の高い結晶では表面のみが有 効な sink, source として働き、さらに十分厚い結 晶を用いると、温度変化によってもたらされる非 平衡状態から平衡状態に移る過程で図4の分布を 作ることが可能になる。

#### 2.5 転位ループの縮小過程と自己拡散

 $c \approx c_o o$ 状態では、 $F_e \ge F_{sf} \in \mathbb{R}$ 動力として転位 ループは収縮する。この場合にも、点欠陥の放出 速度が律速する場合と拡散律速の2つの場合が両 極端のメカニズムとして考えられるが,ここでは 拡散律速として議論を進める。すなわち,転位の 近傍の濃度 c₄は常にその局所平衡濃度 c₄に等しい とする。拡散で運び去られた分だけ転位から点欠 陥が放出される(上昇運動をする)。これは,拡 散方程式を解く問題に帰着し,上昇速度は次式で 表される<sup>7</sup>。

$$\mathbf{v}_{o} = -\frac{\mathrm{d}\mathbf{r}}{\mathrm{d}t}$$
$$= \beta \frac{\mathrm{D}_{s}}{\mathrm{b}_{n}} \left[ exp\left(\frac{\mathrm{F}\,\mathbf{v}_{a}}{\mathrm{k}\mathrm{T}\mathrm{b}_{n}}\right) - 1 \right]$$
(11)

ただし、D<sub>s</sub>は自己拡散係数、Fは駆動力で $F_{\ell}$ + $F_{st}$ に等しい。また係数 $\beta$ はループの大きさに依存する定数で、平板試料の厚さdに較べてループ径が 十分大きければ、直線転位とみなせるが、逆に小さければ点状の発生源とみなされ、以下のように 表わされる<sup>8)</sup>。

$$\beta = \begin{cases} \frac{2\pi}{\ell n (d/2\ell_o)} & (2r \gg d) \\ \frac{4}{\pi} & (2r \ll d) \end{cases}$$
(12)

 $\ell_{e}$ は転位の近傍で局所平衡濃度 c<sub>e</sub>が保たれる距離。XRTで観察されるような r の大きいループでは、 $F_{\ell}$  « $F_{st}$  であり、 $\gamma_{e}$  が小さい場合は、(11)式の指数関数の中は 1 よりも十分小さくなる。そのような場合には、(11) 式は

$$\mathbf{v}_{c} \simeq \beta \frac{\mathbf{D}_{s} \boldsymbol{\gamma}_{st} \mathbf{v}_{s}}{\mathbf{b}_{n}^{2} \mathbf{k} \mathbf{T}}$$
(14)

と簡略される。また,積層欠陥を伴わない完全転 位ループに対しては,

$$-\frac{\mathrm{d}\mathbf{r}^{2}}{\mathrm{d}\mathbf{t}} \simeq 2\beta \frac{\mathrm{D}_{s} \mathbf{v}_{s}}{\mathrm{kT}} \left[ \frac{2-\nu}{2} \mathbf{b}_{p}^{2} \left( \ell n \left( \frac{4\mathbf{r}}{\rho} \right) - 1 \right) + \mathbf{b}_{n}^{2} \ell n \left( \frac{4\mathbf{r}}{\rho} \right) \right]$$
(15)

となる。

(14) 式と(15) 式の比をとると, β D<sub>s</sub>が消え る。すなわち, 完全転位ループと積層欠陥ループ の収縮速度から, 積層欠陥エネルギー γ<sub>s</sub>が決定さ れる<sup>10)11)</sup>。そうすると, (14) 式あるいは(15) 式のどちらを使っても, 自己拡散係数D<sub>s</sub>を決める ことができる。

SR-X線トポグラフィによるその場観察
 1 高速X線トポグラフィカメラ

転位の上昇運動のその場観察には,主として, フォトン・ファクトリー (PF) BL – 15Bに設置 されている高速X線トポグラフィカメラを使用し た。装置の詳細は文献<sup>12)</sup>を参照して頂くことにし て,ここでは,転位の運動を観察するために特に 工夫している点を紹介する。

転位の動的挙動を観察するには、リアルタイム 観察が不可欠であり、X線TVシステム13)を利用 し、図5に示すような構成とした。特に重要な点 は、2画面のフレームメモリーを使用して、その 場で転位の運動の有無を観察できるようにしてい る点である。すなわち、異る時刻のトポグラフ像 をAとB2つのメモリーに格納しておき、それを 交互にモニタ画面に表示させることによって、わ ずかな転位の動きをその場で観察することができ る。実験の次のステップを判断する上でも、これ は欠かせない機能である。また、ビデオテープを 再生して、転位の変位を測定する場合も、この機 能を持つメモリーが不可欠である。撮影時の温 度, 圧力等のデータは, ビデオテープの音声トラ ックにデジタルデータとして録音してあり,再生 時に画面と同期して読み出すことができる。

上記のような観察と測定には,放射光の高輝度 性と共に白色性が役に立っている。一連の観察に おいて,試料もTV管球も動かさないことが肝要で あり,そうしなければ,上で述べた2画面の比較 はほとんど意味を失ってしまう。モノクロメータ を通すと,温度変化による回折条件の変化を追跡



Fig.5. A TV XRT system for real time observations.

するために試料およびTVを回転移動させなければ ならない。試料の温度上昇というやっかいな問題 があるにもかかわらず白色X線を用いる最大の理 由はこの点にある。

#### 3.2 静水圧下におけるトポグラフ観察

冒頭で述べたように、点欠陥パラメータの圧力 依存性を求めることが非常に重要であり、静水圧 下のトポグラフ観察を可能にする必要がある。高 圧力と言っても、氷 I hの圧力範囲は200MPaまで であるから、今の場合それほど大きな圧力が要る 訳ではない。問題は、試料室の大きさにある。前 節で述べた方法を用いるためには、十分厚い試料 を使う必要があり、厚さに較べて十分大きな径の 平板試料を必要とする。氷の場合、必要な厚さは 2~3 mmである。

試料室の大きさを約5 mm× φ 16mmとして, 図6の装置を製作した。試料を圧力媒体と共に圧 カセルの中に封入し,中空の油圧プレスでそれを 圧縮する方式である。透明なアクリル板(厚さ 8 mm)を窓として使用し、150MPaまで加圧で きた。圧力は、シリンダーの油圧から求められる 圧縮力を高圧セルの断面積で除した値としたが、 念のため圧力融解点を確認した。試料室の冷却 は、液体窒素からの蒸発ガスを吹きつける方式に よって行い、0℃から-70℃まで十分な安定度が 得られた<sup>16)19)</sup>。

X線の通路には,吸収係数の小さい材料ばかり であるが,それでもかなりの厚さになるので,透 過率はかなり低下する。観察に適した反射にX線 TVを合わせてから,θ-2θを回転しながら,低 角側(短波長側)に移動して,強度最大の条件に 設定した。だいたい,0.6A近辺で最大となり,こ の時の透過率は約5%である。元々試料の発熱防 止にAlの吸収板を入れているので,これを薄くす ることによって強度不足は,どうにか解決した。

まだ,いくつかの問題点を残しているが,コン パクトな装置で高圧力下のトポグラフ観察が可能 になったことの意義は大きい。



Fig.6. The high – pressure apparatus for in situ  $\chi$  – ray topography <sup>19</sup>.

#### 4. 氷結晶の点欠陥パラメータ

#### 4.1 点欠陥の種類と平衡濃度

点欠陥の種類の同程と平衡濃度の絶対測定法と しては、格子定数と熱膨張の同時測定による Balluffi & Simons法<sup>14</sup>)が有名であるが、点欠陥 濃度が低い場合には極めて困難になる。ここで も、XRTによる転位ループの観察が威力を発揮す る。体積比としてはわずかな量であっても、1原 子層に延ばすと大きな面積になるからである。高 温の平衡状態から冷却した時に、過剰となった点 欠陥が全て転位ループとして析出したものとし て、その数と大きさから過剰になった点欠陥の数 (濃度)が求まる。ただし、過剰点欠陥の全てを 捕捉できるような条件を整える必要がある。冷却 中の点欠陥の拡散距離よりも十分厚い試料を使う ことによって、結晶内部で過剰になった点欠陥が 表面に逃げるのを防ぎ,かつ,過剰点欠陥が転位 ループに析出する時間的余裕があるくらいの冷却 速度で冷却しなければならない。氷の場合、試料 の厚さ5~6mm, 冷却速度200℃/h程度で, こ の条件をほぼ満たすことができる<sup>3)</sup>。

優勢な点欠陥の種類を決めるには、冷却によっ て発生した転位ループの型を決めれば良い。通 常、回折コントラストの違いで空孔型か格子間型 かを決めるが、これはそう簡単ではない。われわ れは、もっと直接的な方法として、ループ面に垂 直応力をかけて、ループが収縮するか拡大するか で型を決定した。例えば、図3(b)の格子間型 ループに上下方向の圧縮応力を加えること、この 刃状転位は右側へ移動する。この結果、氷結晶中 で優勢な点欠陥が自己格子間分子であることは疑 う余地のない事実となった5)。さらに、上記の方法 でその形成エネルギーE<sup>1</sup>,形成エントロピーS<sup>1</sup>が 表1のように求められた。ただし,上記の方法で 直接求まるのは、冷却前の温度と冷却後の温度に おける平衡濃度の差であり、また空孔濃度との差 でもあるが,表1の値はこれらを無視して求めた 値である。この点および測定精度に難点はある が, 10<sup>-7</sup>のオーダーの点欠陥濃度を測定し得たこ とおよび氷という身近かな物質中の点欠陥の基本 的性質を決定した事は、 XRT研究の大きな成果の 1つと自負している。

#### 4.2 拡散係数

2. 4節で述べた方法を用いて自己格子間分子の拡散係数D'を求めるためには、試料に適当な温









Fig.7. Climb motion of dislocations in ice 18).

度変化を与え、上昇運動をトポグラフ観察すれば 良い。濃度測定とは違って、図4のようななだら かな濃度分布が必要であるから、比較的薄い試料 (2~3mm)に数+℃/hの温度変化を与えた後、 温度を一定に保つ。図7は、この時のトポグラフ 観察側である。X、Y等の記号で示した転位が**b**= **c**(**c**は紙面に垂直)の完全転位ループであり、紙 面(底面)に沿って上昇運動をする。左下の写真 は、トポグラフAとその10分後に撮影されたトポ グラフBの差分像であり、X、Y等の転位が白線 から黒線まで距離 d 動いているのが分かる。転位 KとLは、バーガース・ベクトルbが紙面に平行 であり、全く動いていない。このような観察から、転位の上昇運動距離を時間の関数として測定することができる。図8に測定例を温度変化と共に示した。このグラフで上昇距離が飽和した値が、(10)式の $L_r$ であり、 $\ell n$  ( $L_r - L$ )と時間 t のプロットから、D'が図9のように求められ、移動の活性化エネルギー $E_m^{-1}$ とエントロピー項D'が表1のように求められている。

温度を長時間一定に保つと、2.5節で述べた 転位ループの縮小過程が観察される。図10に収縮 速度のグラフを示したが、積層欠陥ループの方は 様々な速度が得られる。これは、図11に示すよう



Fig.9. Diffusion coefficient of self - interstitials in ice 18).

Table	1	Self-interstitial	parameters	for	ice	
	-					

c.1 (mole fraction)	$E_{f}^{+}$ (eV)	Sr <sup>1</sup> /k	$D^{I}$ ( $m^{a}/s$ )	$E_m^1$ (eV)	$D_o^1 (m^*/s)$
$2.8  imes 10^{-6}$	0.40	4.9	$2.0 \times 10^{-9}$	0.16	$1.8 \times 10^{-6}$
(at T <sub>m</sub> )			(at T <sub>m</sub> )		

k: ボルツマン定数

に、転位のバーガース・ベクトルの大きさに相違 があるためであり、(14) 式中のb,がc/2の整数 倍になっていることによるものである。図10の番 号1のデータが、b<sub>n</sub>=c/2(図11の(c))に対 応するもので、図3(a)の構造を持つと考えられ る。この収縮速度と完全転位ループの収縮速度(図 10の挿入図)の比から、この積層欠陥のエネル ギー $\gamma_{st}$ が0.31mJ/mと決定された<sup>11</sup>。これは非 常に小さな値であり,氷結晶中に大面積の積層欠 陥が容易に現れることの原因である。また、立法 晶の氷I。とI。のエネルギー差が非常に小さい(16J /mole) ことを意味している。

氷の自己拡散係数は、トレーサ法で数多くの測 定例がある。前節で述べた平衡濃度c.とD.の積 が、トレーサ法の結果と良く一致することが確認





されており<sup>4</sup>, また上記の結果から(14), (15) 式を用いて求められるD,の値もほぼ良い一致を示 す。



Fig.11. X – ray topographs of the faulted loops <sup>11)</sup>. Shrinkage data 1,3 and 4 in Fig 10 were measured on the loops (c), (b) and (a), respectively.

#### 4.3 平衡濃度と拡散係数の圧力依存性

冒頭で述べたように,自己拡散係数と融解現象の間には一定の関係がある。金属や1部の分子性結晶では,自己拡散の活性化エンタルピーH。が融点Tmに比例することが経験的に知られている。すなわち

$$D_s = D_o exp(-\gamma T_m/T)$$
(16)

 $\gamma$ は定数である。自己拡散の活性化体積を $V_s$ とすると、

$$V_{s} = -kT \left( \frac{\partial \ell n D_{s}}{\partial p} \right)_{T} = k\gamma \left( \frac{\partial T_{m}}{\partial p} \right)$$
(17)

$$H_{s} = -k \left( \frac{\partial \ell n D_{s}}{\partial (1/T)} \right)_{p} = k \gamma T_{m}$$
(18)

となり、Clausius-Clapeyronの式を用いて次の 関係式を得る。

$$\frac{V_s}{H_s} = \frac{\Delta V_m}{\Delta H_m}$$
(19)

ただし、 $\Delta H_m \ge \Delta V_m$ は融解時のエンタルピー変化 (融解熱) と体積変化である。氷の場合、 $\Delta V_m < 0$ であるから、 $V_s$ も負の値 – 0.82 $V_s$ が期待される。 しかし、

$$V_s = V_f + V_m \tag{20}$$

であり、点欠陥の形成体積 V<sub>t</sub>と移動の活性化体積 V<sub>m</sub>を独立に検討する必要がある。

まずV<sub>t</sub>については、分子容V<sub>e</sub>と点欠陥のまわりの体積緩和V<sub>t</sub>を用いて、格子間原子に対して、

$$V_{f}^{1} = -V_{a} + V_{r}^{1}$$
 (21)

と表わされる。要するに、表面の原子を1個格子 間位置に押し込んで(-V<sub>\*</sub>),まわりの格子を少 し膨張させる(+V<sup>!</sup>)と、系全体でV<sup>!</sup>の体積変化 を生ずる。空孔はこの逆であるが、いずれにせよ V<sub>\*</sub>>V<sub>r</sub>であるから、V<sup>\*</sup><sub>f</sub>>0でV<sup>!</sup><sub>f</sub><0である。す なわち、圧力の増加によって、空孔濃度c<sup>\*</sup>は減少 し、c<sup>\*</sup>は増加する。温度変化の代りに圧力を変化



Fig.12. Diffusion coefficient of self – interstitials in ice as a function of pressure <sup>19</sup>.

させて,発生する転位ループの数から,V<sub>f</sub>'を求めることができる。結果は,大略-0.8V<sub>a</sub>と見積もられている<sup>15)</sup>。

一方、V<sub>m</sub>の方は、ごく最近高圧下のXRT観察 によって初めて求められた<sup>19)</sup>。図12に示すよう に、100MPaまでのD<sup>'</sup>の測定に成功し、V<sub>m</sub>≈0.37V。 が得られた。これは、格子間分子の移動に伴っ て、分子容の3分の1程度の体積膨張が生ずるこ とを意味している。上記のV<sub>f</sub>の値と合わせると、 V<sub>s</sub>≈ - 0.4V<sub>s</sub>と負の値が得られるが、(19)式の予 測値には及ばない。また、ループの収縮速度から 求めたD<sub>s</sub>の圧力依存性はむしろV<sub>s</sub>> 0を示してお り<sup>16)</sup>、常圧下のようなコンシステントな結果は得 られていない。さらに、NMRによる緩和時間測定 の結果は、高圧ほど緩和時間が短くなる傾向を示 しており、V<sub>s</sub>≈ - 0.56V<sub>s</sub>が報告されている<sup>1)</sup>。

以上のように,高圧下の点欠陥パラメータはま だ確定されていないので,(19)式が成立するか 否か分らないというのが現状である。しかし,常 圧下で成功を収めたXRTによる測定が,高圧下で も有効であることは,D'の測定に成功したことで も明らかであり,今後の研究の進展によってこの 問題に実験事実をもって答えることができよう。 5. おわりに

XRTという巨視的な観察手法を使って点欠陥と いうミクロ欠陥の挙動を定量的に明らかにし得る ことを氷結晶を例として説明した。特に強調した いのは,一連の手法は,平衡濃度と点欠陥拡散係 数を独立に測定できるという他の方法にはない特 徴を持っているという点である。さらに,後者の 測定には非平衡状態から平衡状態に変化する途中 を観察することが本質的に必要であり,高速XRT の出現なしには不可能な実験である。今後は,融 解現象の問題と絡めて,高圧下における測定に重 点を置いて研究を進める予定であり,ますますシ ンクロトロン放射光の重要度が増すことになろ う。

ここで紹介した研究は、下記の方々との共同研 究であり、記して感謝の意を表します。東晃北大 名誉教授(現国際基督教大教授)ならびに伊藤泰 蔵(現トムソンジャパン),東久美子(現長岡雪 氷防災実験所),雨海真也(現NKK),星亮二 (現信越半導体),金原滋(北大工学部)の各氏 である。また、桐谷道雄名古屋大学教授には、測 定方法についてご教示を頂いた。深く感謝致しま す。

#### 文献

- J.M. Chezeau, S. Mc Guigan and J.H. Strange, Dynamics of Molecular Crystals (Elsevier 1986) 491.
- T. Hondoh, T. Itoh and A. Higashi, Jpn. J. Appl. Phys., 20, L737(1981).
- K. Goto, T. Hondoh and A. Higashi, Point Defects and Defect Interactions in Metals(University of Tokyo Press 1982)174.
- K. Goto, T. Hondoh and A. Higashi, Jpn. J. Appl. Phys., 25, 351(1986).
- T. Hondoh, K. Azuma and A. Higashi, J. Phys., 48, Cl-183(1987).
- 6) M. Eldrup, J. Chem. Phys., 64, 5283(1976).
- J.P. Hirth and J. Lothe, Theory of Dislocations(Mc Graw-Hill 1968) 557.
- D.N. Seidman and R.W. Balluffi, Phil. Mag., 13, 649(1966).
- M. Kiritani and H. Takata, J. Nucl. Mater. 69/70, 277(1978).
- P.S. Dobson, P.J. Goodhew and R.E. Smallman, Phil. Mag. 16, 9(1967).
- 11) T. Hondoh, T. Itoh, S. Amakai, K. Goto and A.

Higashi, J. Phys. Chem., 87, 4040 (1983)

- S. Suzuki, M. Ando, K. Hayakawa, O. Nittono, H. Hashizume, S. Kishino and K. Kohra, Nucl. Instr. Meth. Phys. Research, 227, 584 (1984)
- J. Chikawa, F. Sato, T. Kawamura, T. Kuriyama, T. Yamashita and N. Goto, X- ray Instrumentation for the Photon Factory:Dynamic Anaiyses of Micro Structures in Matter (KTK Scientific Pub. 1986) 145.
- 14) R.O. Simmons and R.W. Balluffi, Phys. Rev., 117, 52 (1960).
- 15) 後藤久美子,北海道大学博士論文(1986).
- 16) 星亮二, 北海道大学修士論文 (1990).
- 17) A. Fukuda, T. Hondoh and A. Higashi. J. Phys.,48, C1-163 (1987).
- T. Hondoh, A. Goto, R. Hoshi, T. Ono, H. Anzai,
   R. Kawase, P. Pimienta and S. Mae, Rev. Sci. Instrum., 60, 2494 (1989).
- T. Hondoh, R. Hoshi, A. Goto and H. Yamagami, Phil. Mag., 63, 1 (1991).
- 20) J.W. Corbett and J.C. Bourgoin, Point Defects in Solids vol.2 (Plenum Press 1975) 25.

# きってい

#### 転位ループ (dislocation loop)

閉曲線をなす転位は全て転位ループと呼ばれるが、 この解説では、点欠陥の析出によって生ずる転位ルー プのみを考えている。すなわち、原子空孔あるいは自 己格子間原子がある特定の結晶面上に板状に析出する と、その周縁に転位が発生し、転位ループとなる。こ の時、厚みが格子周期の整数倍であれば、ループ内部 は元の結晶と同じ構造になり、完全転位ループと呼ば れる。整数倍ではない時は、ループ面に積層欠陥を伴 う転位ループ(faulted loop)になる。

転位の上昇運動 (climb motion of dislocation) 下図の泡模型を参照して頂きたい。図(a)を原子列 (3方向)に沿って横から見ると、 上印のところで原 子列が途切れているのが分る。これが刃状転位である。 ただし、3つの原子列のうち、水平方向の原子列は途 切れていない。この刃状転位が水平方向にAA' 面上を 動くと、この面を境いに上下の結晶が相対的に1原子 間距離横にずれる。これをすべり運動といい、この面 をすべり面という。一方,この転位が上下方向に動く ためには、途切れた原子列を補うか除いてやらねばな らない。この図では、過剰に存在する空孔を吸収して 上へ動いている。このようなすべり面に垂直な方向へ の運動を上昇運動という。X線トポグラフィでは、空 孔のような点欠陥を観ることはできないが, その挙動 は転位の上昇運動を観察すれば分るというのが、本解 説の趣旨である。





